

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-302639

(43)公開日 平成11年(1999)11月2日

(51)Int.Cl.⁶

C 0 9 K 11/06

H 0 5 B 33/14

識別記号

6 2 0

F I

C 0 9 K 11/06

H 0 5 B 33/14

6 2 0

B

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全 17 頁)

(21)出願番号 特願平10-118249

(22)出願日 平成10年(1998)4月28日

(31)優先権主張番号 特願平10-34529

(32)優先日 平10(1998)2月17日

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 佐藤 佳晴

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 市野澤 晶子

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 緒方 朋行

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 弁理士 長谷川 曉司

(54)【発明の名称】 有機電界発光素子

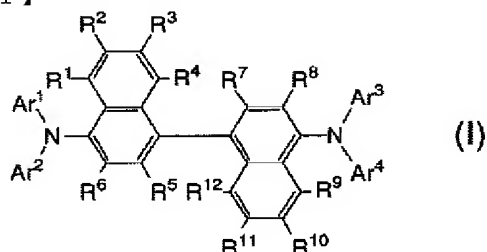
(57)【要約】

【課題】 色純度が良好な青色発光が達成でき、且つ安定性の向上した有機電界発光素子の提供。

【解決手段】 基板上に、陽極及び陰極により挟持された正孔輸送層、発光層及び電子輸送層を少なくとも含む有機電界発光素子であって、該発光層が下記一般式

(I) で表わされるビナフチル骨格を有する芳香族アミンを含有することを特徴とする有機電界発光素子。

【化1】



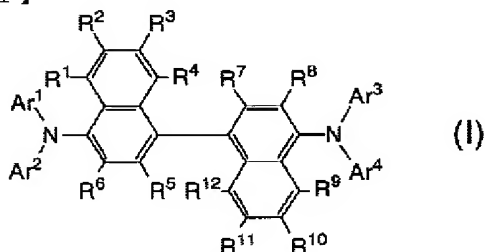
(式中、Ar¹ ないし Ar⁴ は、各々独立して、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を示し、R¹ ないし R

¹²は、各々独立して、水素原子、シアノ基、カルボキシ基、水酸基、又は各々置換基を有していてもよい、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アミノ基、アミド基、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族炭化水素基或いは芳香族複素環基を示す)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、陽極及び陰極により挟持された正孔輸送層、発光層及び電子輸送層を少なくとも含む有機電界発光素子であって、該発光層が下記一般式(I)で表わされるビナフチル骨格を有する芳香族アミンを含有することを特徴とする有機電界発光素子。

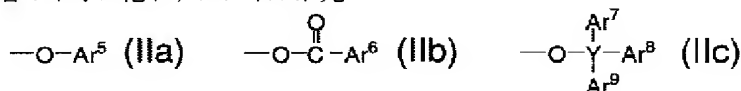
【化1】



(式中、Ar¹ ないし Ar⁴ は、各々独立して、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を示し、R¹ ないし R¹² は、各々独立して、水素原子、シアノ基、カルボキシ基、水酸基、又は各々置換基を有していてもよい、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アミノ基、アミド基、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族炭化水素基或いは芳香族複素環基を示す)

【請求項2】 発光層と電子輸送層との間に、正孔阻止層を設けたことを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 正孔阻止層のイオン化ポテンシャルが発*

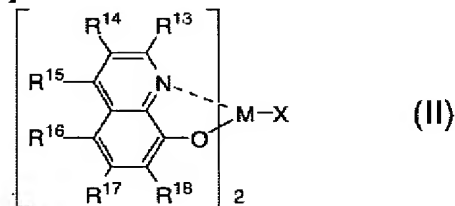


(式中、YはSi、Ge又はSnのいずれかの原子を表わし、Ar⁵ ないし Ar⁹ は、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香*

* 光層のイオン化ポテンシャルよりも0.2 eV以上大きいことを特徴とする請求項2に記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 正孔阻止層が、下記一般式(II)又は(III)で表わされる金属錯体、下記構造式(IV)を少なくとも一個含むトリアゾール誘導体、下記一般式(V)で表わされるスチリル化合物の少なくとも一種で構成されることを特徴とする請求項2又は3に記載の有機電界発光素子。

【化2】

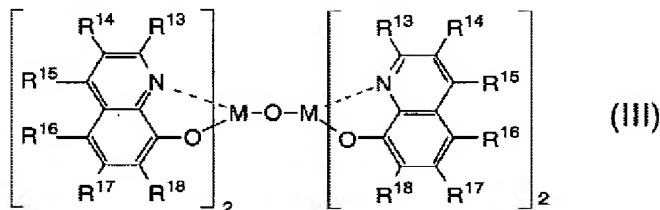


(式中、R¹³ ないし R¹⁸ は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アリル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシ基、アルコキシ基、アルキルスルホニル基、α-ハロアルキル基、水酸基、置換基を有していてもよいアミド基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わす。一般式(II)中、MはAl原子又はGa原子を示し、Xは下記一般式(IIa)、(IIb)又は(IIc)のいずれかを表わす)

【化3】

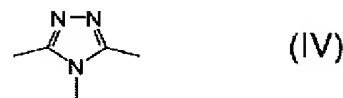
※族複素環基を表わす)

【化4】

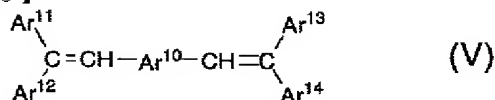


(式中、R¹³ ないし R¹⁸ は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アリル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシ基、アルコキシ基、アルキルスルホニル基、α-ハロアルキル基、水酸基、置換基を有していてもよいアミド基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わし、MはAl原子又はGa原子を示す)

★【化5】



【化6】



(式中、 Ar^{10} は置換基を有していてもよい二価の芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい二価の芳香族複素環基を表わし、 Ar^{11} ないし Ar^{14} は、各々独立して、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わす)

【請求項5】 正孔阻止層の膜厚が、0.5～30nmの範囲にあることを特徴とする請求項2ないし4のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 発光層のイオン化ポテンシャルが、正孔輸送層のイオン化ポテンシャルよりも0.1eV以上小さいことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子に関する。詳しくは、特定の芳香族アミン化合物を含有する発光層を有する有機電界発光素子に関する。本発明の有機電界発光素子は、色純度のよい青色発光が達成でき、且つ安定性が向上しているので、フラットパネル・ディスプレイやマルチカラー表示素子或いは面発光体としての特徴を生かした光源等への応用が期待される。

【0002】

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光(EL)素子としては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZnS、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類元素(Eu、Ce、Tb、Sm等)をドーパしたものが一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL素子は、

- 1) 交流駆動が必要(50～1000Hz)、
 - 2) 駆動電圧が高い(～200V)、
 - 3) フルカラー化が困難(特に青色)、
 - 4) 周辺駆動回路のコストが高い、
- という問題点を有している。

【0003】しかし、近年、上記問題点の改良のため、有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるようになった。特に、発光効率を高めるため、電極からのキャリア注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行い、芳香族ジアミンから成る正孔輸送層と8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体から成る発光層とを設けた有機電界発光素子の開発(Appl. Phys. Lett., 51巻, 913頁, 1987年)により、従来のアントラセン等の単結晶を用いたEL素子と比較して発光効率の大幅な改善がなされている。また、例えば、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等のレーザー用蛍光色素をドーパすること(J. Appl. Phys., 65巻, 3610頁, 1989年)により、発光効率の向上や発光波長の変換等も行われている。

【0004】上記の様な低分子材料を用いた電界発光素子の他にも、発光層の材料として、ポリ(p-フェニレ

ンビニレン)(Nature, 347巻, 539頁, 1990年)、ポリ〔2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン〕(Appl. Phys. Lett., 58巻, 1982頁, 1991年他)、ポリ(3-アルキルチオフェン)(Jpn. J. Appl. Phys., 30巻, L1938頁, 1991年)等の高分子材料を用いた電界発光素子の開発や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に低分子の発光材料と電子移動材料を混合した素子(応用物理, 61巻, 1044頁, 1992年)の開発も行われている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】有機電界発光素子をフラットパネル・ディスプレイ等の表示素子に应用するためには、素子の信頼性を十分に確保する必要がある。しかしながら、従来の有機電界発光素子では耐熱性が不十分であり、素子の環境温度やプロセス温度の上昇により電流-電圧特性が高電圧側にシフトしたり、素子駆動時の局所的なジュール発熱により寿命が低下したり、非発光部分(ダークスポット)の発生及び増加等の劣化が避けられなかった。特に、青色発光素子に関しては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体を用いた緑色発光素子と比較して、素子の安定性が劣っているのが現状である。

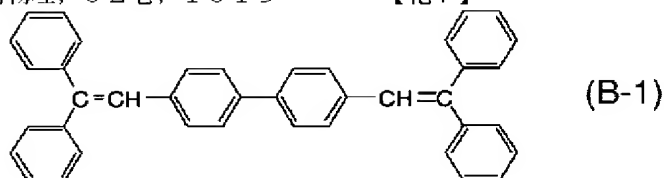
【0006】上記の素子劣化の主要原因は、有機層の薄膜形状の劣化である。この薄膜形状の劣化は、素子駆動時の発熱等による有機非晶質薄膜の結晶化(又は凝集)等に起因すると考えられている。この耐熱性の低さは材料のガラス転移温度(以下T_gと略記する)の低さに由来すると考えられる。T_gは一般的に融点と直線相関がある。青色発光素子の発光層に用いられる化合物は、パイ電子共役を拡張されないという制約から、分子量が低く融点及びT_gが低い材料が多い。また、化学的にも十分安定とは言えないのが現状である。

【0007】これまで、青色有機電界発光素子に用いられた化合物としては、アントラセン(Jpn. J. Appl. Phys., 27巻, L269頁, 1988年)、テトラフェニルブタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン(Appl. Phys. Lett., 56巻, 799頁, 1990年)、ジスチリルベンゼン誘導体(日本化学会誌, 1162頁, 1992年)、オキサジアゾール誘導体(Jpn. J. Appl. Phys., 31巻, 1812頁, 1992年; 日本化学会誌, 1540頁, 1991年)、アゾメチン亜鉛錯体(Jpn. J. Appl. Phys., 32巻, L511頁, 1993年)、ベンズアゾール金属錯体(特開平8-81472号公報)、混合配位子アルミニウム錯体(特開平5-198377号公報; 特開平5-198378号公報; 特開平5-214332号公報; 特開平6-172751号公報)、N, N'-ジフェニル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル

-4, 4'-ジアミン (Jpn. J. Appl. Phys., 32巻, L917頁, 1993年)、ポリビニルカルバゾール (Appl. Phys. Lett., 63巻, 2627頁, 1993年)、1, 2, 4-トリアゾール誘導体 (Chem. Lett., 47頁, 1996年)、アミノピレン二量体 (Jpn. J. Appl. Phys., 35巻, 4819頁, 1996年)、ジスチリルビフェニル誘導体 (応用物理, 62巻, 1015 * 頁, 1993年; Appl. Phys. Lett., 67巻, 3853頁, 1995年)、シロール誘導体 (J. Am. Chem. Soc., 118巻, 11974頁, 1996年) 等が報告されている。上記の青色発光材料のなかで、素子特性がよく検討されている代表的化合物を以下に示す。

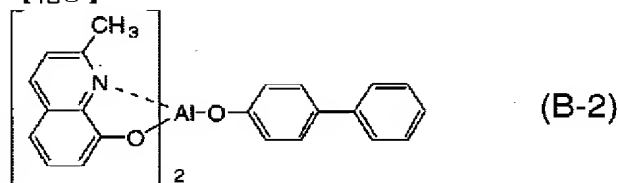
【0008】

【化7】



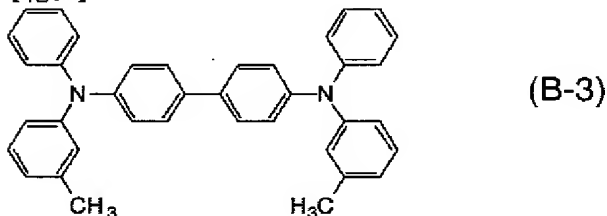
【0009】

【化8】



【0010】

【化9】



【0011】ジスチリルビフェニル誘導体 (B-1) は、蛍光強度が強く素子に用いた時にもエキサイプレックスを形成せず、青色発光が報告されているが (Appl. Phys. Lett., 67巻, 3853頁, 1995年)、薄膜状態でイオン化ポテンシャルが5.9 eVと高く、正孔輸送層から正孔が注入しにくく、また、ELスペクトルでは480 nm付近に発光極大を有するブロードなピークを示し、青色の色純度がよくないという問題がある。この色純度はドーピングを行っても改善されていない。ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (p-フェニルフェノラト) アルミニウム錯体 (B-2) も青色の色純度が不十分で、ペリレンをドーピングすることで色純度は改善されるものの、駆動時の安定性が実用レベルには達していない (特開平5-198377号公報)。芳香族ジアミンであるN, N'-ジフェニル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン (通常TPDと呼ばれる) は、正孔阻止層としてのトリアゾール誘導体と組み合わせた時に464 nmに発光ピークを有するELスペクトル※50

※ルを示すが (Jpn. J. Appl. Phys., 32巻, L917頁, 1993年)、TPDのTgは63℃と低いために結晶化等の熱的不安定性を有する。車載用表示素子の高温特性から、Tgの値として85℃以上が要求される。

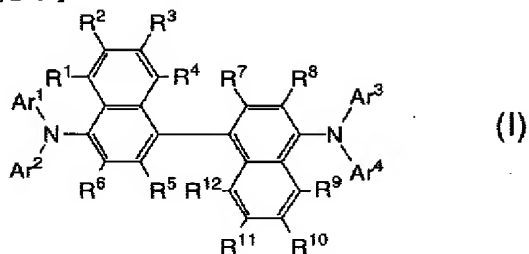
20 【0012】上述の理由から、青色有機電界発光素子は実用化に向けて、発光の色純度の問題と、更には素子の耐熱性及び駆動寿命に大きな問題を抱えているのが実状である。有機電界発光素子の青色純度が改善されず、耐熱性と駆動特性が不安定なことは、フルカラー化を目指すフラットパネル・ディスプレイ等の表示素子として望ましくない特性である。本発明は、青色純度が高く、且つ耐熱性を有する有機電界発光素子を提供することを目的とする。

【0013】

30 【課題を解決するための手段】本発明者らは、かかる実状に鑑み鋭意検討した結果、特定の芳香族アミン化合物を含有する発光層を用いることにより上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明の要旨は、基板上に、陽極及び陰極により挟持された正孔輸送層、発光層及び電子輸送層を少なくとも含む有機電界発光素子であって、該発光層が下記一般式 (I) で表わされるビナフチル骨格を有する芳香族アミンを含有することを特徴とする有機電界発光素子、

【0014】

40 【化10】



【0015】(式中、Ar¹ ないしAr⁴ は、各々独立して、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は

置換基を有していてもよい芳香族複素環基を示し、 R^1 ないし R^{12} は、各々独立して、水素原子、シアノ基、カルボキシル基、水酸基、又は各々置換基を有していてもよい、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アミノ基、アミド基、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族炭化水素基或いは芳香族複素環基を示す)にある。

【0016】

【発明の実施の形態】以下、本発明の有機電界発光素子について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明に用いられる一般的な有機電界発光素子の構造例を模式的に示す断面図であり、1は基板、2は陽極、4は正孔輸送層、5は発光層、7は電子輸送層、8は陰極を各々表わす。

【0017】基板1は有機電界発光素子の支持体となるものであり、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチックフィルムやシート等が用いられる。特にガラス板や、ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスルホン等の透明な合成樹脂の板が好ましい。合成樹脂基板を使用する場合にはガスバリア性に留意する必要がある。基板のガスバリア性が小さすぎると、基板を通過した外気により有機電界発光素子が劣化することがあるので好ましくない。このため、合成樹脂基板の少なくとも片面に緻密なシリコン酸化膜等を設けてガスバリア性を確保する方法も好ましい方法の一つである。

【0018】基板1上には陽極2が設けられるが、陽極2は正孔輸送層への正孔注入の役割を果たすものである。この陽極は、通常、アルミニウム、金、銀、ニッケル、パラジウム、白金等の金属、インジウム及び／又はスズの酸化物等の金属酸化物、ヨウ化銅等のハロゲン化金属、カーボンブラック、或いは、ポリ(3-メチルチオフェン)、ポリピロール、ポリアニリン等の導電性高分子等により構成される。陽極2の形成は通常、スパッタリング法、真空蒸着法等により行われることが多い。また、銀等の金属微粒子、ヨウ化銅等の微粒子、カーボンブラック、導電性の金属酸化物微粒子、導電性高分子微粉末等の場合には、適当なバインダー樹脂溶液に分散し、基板1上に塗布することにより陽極2を形成することもできる。更に、導電性高分子の場合は電解重合により直接基板1上に薄膜を形成したり、基板1上に導電性高分子を塗布して陽極2を形成することもできる(Appl. Phys. Lett., 60巻, 2711頁, 1992年)。陽極2は異なる物質で積層して形成することも可能である。陽極2の厚みは、必要とする透明性により異なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透過率を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とすることが望ましく、この場合、厚みは、通常、5~1000nm、好ましくは10~500nm程度である。不透明でよい場合は陽極2は基板1と同一でもよい。ま

た、更には上記の陽極2の上に異なる導電材料を積層することも可能である。

【0019】陽極2の上には正孔輸送層4が設けられる。正孔輸送層の材料に要求される条件としては、陽極からの正孔注入効率が高く、且つ、注入された正孔を効率よく輸送することができる材料であることが必要である。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、可視光の光に対して透明性が高く、しかも正孔移動度が大きく、更に安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。上記の一般的な要求以外に、車載表示用の応用を考えた場合、素子には更に耐熱性が要求される。従って、 T_g として85℃以上の値を有する材料が望ましい。

【0020】このような正孔輸送材料としては、例えば、1, 1'-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン等の第三級芳香族アミン単位を連結した芳香族ジアミン化合物(特開昭59-194393号公報)、4, 4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニルで代表される二個以上の第三級アミンを含み二個以上の縮合芳香族環が窒素原子に置換した芳香族アミン(特開平5-234681号公報)、トリフェニルベンゼンの誘導体でスターバースト構造を有する芳香族トリアミン(米国特許第4, 923, 774号明細書)、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)ビフェニル-4, 4'-ジアミン等の芳香族ジアミン(米国特許第4, 764, 625号明細書)、分子全体として立体的に非対称なトリフェニルアミン誘導体(特開平4-129271号公報)、ビレニル基に芳香族ジアミノ基が複数個置換した化合物(特開平4-175395号公報)、エチレン基で第三級芳香族アミン単位を連結した芳香族ジアミン(特開平4-264189号公報)、スチリル構造を有する芳香族ジアミン(特開平4-290851号公報)、チオフェン基で芳香族第三級アミン単位を連結したもの(特開平4-304466号公報)、スターバースト型芳香族トリアミン(特開平4-308688号公報)、ベンジルフェニル化合物(特開平4-364153号公報)、フルオレン基で第三級アミンを連結したもの(特開平5-25473号公報)、トリアミン化合物(特開平5-239455号公報)、ビスジピリジルアミノビフェニル(特開平5-320634号公報)、N, N, N'-トリフェニルアミン誘導体(特開平6-1972号公報)、フェノキサジン構造を有する芳香族ジアミン(特開平7-138562号公報)、ジアミノフェニルフェナントリジン誘導体(特開平7-252474号公報)、シラザン化合物(米国特許第4, 950, 950号明細書)、シラナミン誘導体(特開平6-49079号公報)、ホスファミン誘導体(特開平6-25659号公報)、キナクリドン化合物等が挙げられる。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じ

て、各々、混合して用いてもよい。

【0021】上記の化合物以外に、正孔輸送層の材料として、ポリビニルカルバゾールやポリシラン (App 1. Phys. Lett., 59巻, 2760頁, 1991年)、ポリフォスファゼン (特開平5-310949号公報)、ポリアミド (特開平5-310949号公報)、ポリビニルトリフェニルアミン (特開平7-53953号公報)、トリフェニルアミン骨格を有する高分子 (特開平4-133065号公報)、トリフェニルアミン単位をメチレン基等で連結した高分子 (Synthetic Metals, 55~57巻, 4163頁, 1993年)、芳香族アミンを含有するポリメタクリレート (J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 21巻, 969頁, 1983年) 等の高分子材料が挙げられる。

【0022】上記の正孔輸送材料を塗布法或いは真空蒸着法により前記陽極2上に積層することにより正孔輸送層4を形成する。塗布法の場合は、正孔輸送材料を一種又は二種以上と、必要により正孔のトラップにならないバインダー樹脂や塗布性改良剤等の添加剤とを添加し、溶解して塗布溶液を調製し、スピンコート法等の方法により陽極2上に塗布し、乾燥して正孔輸送層4を形成する。バインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等が挙げられる。バインダー樹脂は添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少ない方が望ましく、通常、50重量%以下が好ましい。

【0023】真空蒸着法の場合には、正孔輸送材料で真空容器内に設置された坩堝に入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで 10^{-4} Pa程度にまで排気した後、坩堝を加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、坩堝と向き合って置かれた基板1上の陽極2上に正孔輸送層4を形成させる。正孔輸送層4を形成する場合、更に、アクセプタとして、芳香族カルボン酸の金属錯体及び／又は金属塩 (特開平4-320484号公報)、ベンゾフェノン誘導体及びチオベンゾフェノン誘導体 (特開平5-295361号公報)、フラレン類 (特開平5-331458号公報) 等を 10^{-3} ~10重量%の濃度でドーピングして、フリーキャリアとしての正孔を生成させることにより、低電圧駆動を可能にすることができる。

【0024】正孔輸送層4の膜厚は、通常、10~300 nm、好ましくは30~100 nmである。この様に薄い膜を一樣に形成するためには、一般に真空蒸着法がよく用いられる。陽極2と正孔輸送層4のコンタクトを向上させるために、図3に示す様に、陽極バッファ層3を設けることが考えられる。陽極バッファ層に用いられる材料に要求される条件としては、陽極とのコンタクトがよく均一な薄膜が形成でき、熱的に安定、即ち、融点及びガラス転移温度が高く、融点としては300℃以上、ガラス転移温度としては、100℃以上が要求される。更に、イオン化ポテンシャルが低く陽極からの正孔

注入が容易なこと、正孔移動度が大きいことが挙げられる。この目的のために、これまでにポルフィリン誘導体やフタロシアニン化合物 (特開昭63-295695号公報)、スターバースト型芳香族トリアミン (特開平4-308688号公報)、ヒドラゾン化合物 (特開平4-320483号公報)、アルコキシ置換の芳香族ジアミン誘導体 (特開平4-220995号公報)、p-(9-アントリル)-N,N-ジ-*p*-トリルアニリン (特開平3-111485号公報)、ポリチエニレンビニレンやポリ-*p*-フェニレンビニレン (特開平4-145192号公報)、ポリアニリン (App 1. Phys. Lett., 64巻, 1245頁, 1994年参照) 等の有機化合物や、スパッタ・カーボン膜 (特開平8-31573号公報) や、バナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、モリブデン酸化物等の金属酸化物 (第43回応用物理学関係連合講演会, 27-a-SY-9, 1996年) が報告されている。

【0025】上記陽極バッファ層材料としてよく使用されている化合物としては、ポルフィリン化合物又はフタロシアニン化合物が挙げられる。これらの化合物は中心金属を有していてもよいし、無金属のものでもよい。好ましいこれらの化合物の具体例としては、以下の化合物が挙げられる：

ポルフィン

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフィン

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフィンコバルト (II)

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフィン銅 (II)

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフィン亜鉛 (II)

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23H-ポルフィンバナジウム (IV) オキシド

5, 10, 15, 20-テトラ(4-ピリジル)-21H, 23H-ポルフィン

29H, 31H-フタロシアニン

銅 (II) フタロシアニン

亜鉛 (II) フタロシアニン

チタンフタロシアニンオキシド

マグネシウムフタロシアニン

銅フタロシアニン

銅 (II) 4, 4', 4'', 4'''-テトラアザ-29H, 31H-フタロシアニン

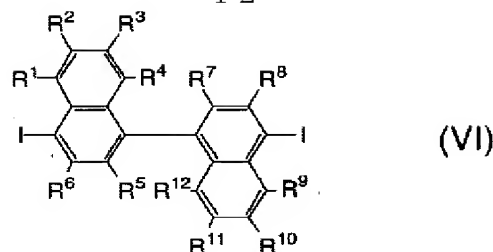
【0026】陽極バッファ層の場合も、正孔輸送層と同様にして薄膜形成可能であるが、無機物の場合には、更に、スパッタ法や電子ビーム蒸着法、プラズマCVD法が用いられる。以上の様にして形成される陽極バッファ層3の膜厚は、通常、3~100 nm、好ましくは10~50 nmである。

【0027】正孔輸送層4の上には発光層5が設けられる。本発明において、発光層5は、電界を与えられた電極間において、陽極2から注入され正孔輸送層を通過して輸送された正孔と、陰極8から注入され電子輸送層7を通過して輸送された電子を効率よく再結合させることにより青色発光する化合物より形成される。そのためには、正孔輸送性と電子輸送性の両方を兼ね備え、しかも正孔移動度及び電子移動度が大きく、更に安定性に優れたトラップとなる不純物が製造時或使用時に発生しにくい化合物であることが要求される。また、青色発光を可能にするために、薄膜状態での蛍光波長が400～500 nmの範囲にあることが必要である。素子通電時に発光層5における正孔濃度を高めるために、正孔輸送層のイオン化ポテンシャルより0.1 eV以上小さい値を有することも発光効率向上に有効である。

【0028】本発明の有機電界発光素子は発光材料として前記一般式(I)で表わされる化合物から選ばれた一つ、又は、二つ以上の混合物から成ることを特徴とする。前記一般式(I)において、好ましくは、 Ar^1 ないし Ar^4 は、各々独立して、各々置換基を有していてもよい、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニル基、ピリジル基、チエニル基を示し、前記置換基としてはハロゲン原子；メチル基、エチル基等の炭素数1～6のアルキル基；ビニル基等のアルケニル基；メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1～6のアルコキシカルボニル基；メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1～6のアルコキシ基；フェノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキシ基；ジエチルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基を示す。 R^1 ないし R^{12} は、好ましくは、各々独立して、水素原子；ハロゲン原子；水酸基；メチル基、エチル基等の炭素数1～6のアルキル基； α -ハロアルキル基；ビニル基等のアルケニル基；フェニル基、ビフェニル基等の芳香族炭化水素基；メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1～6のアルコキシカルボニル基；メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1～6のアルコキシ基；フェノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキシ基；ジエチルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基；ジベンジルアミノ基、ジフェニルアミノ基等のジアリールアミノ基であり、飽和若しくは不飽和の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ジアルキルアミノ基、ジアリールアミノ基は置換基を有していてもよい。一般式(I)で表わされる化合物は、例えば、以下の経路で合成される。下記一般式(VI)で表わされるビナフチル誘導体のヨウ素化物と下記一般式(VII)

【0029】

【化11】



【0030】

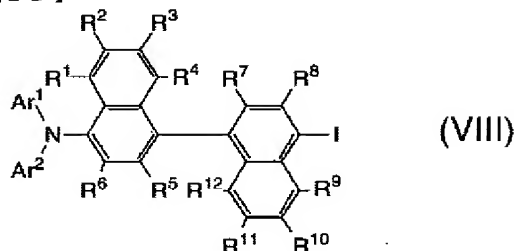
10 【化12】



【0031】で表わされる第二級アミン誘導体をウルマン(Ullmann)反応(Organic Synthesis, 1巻, 544頁)にて反応させ、生成した下記一般式(VIII)で表わされる一置換体をカラムクロマトグラフィーで分離した後に

20 【0032】

【化13】



30 【0033】、下記一般式(IX)で表わされる第二級アミン誘導体と、同様にウルマン反応さ

【0034】

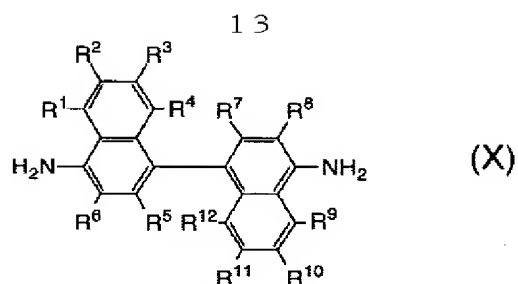
【化14】



【0035】せて目的の一般式(I)で表わされる芳香族アミン化合物を得る。以上の合成例の他に、 Ar^1 ないし Ar^4 が同一の置換基である場合は、下記一般式(X)で表わされるナフチジン誘導体と下記一般式(XI)で表わされるヨウ素化物を同様

【0036】

【化15】



【0037】

【化16】

Ar¹—I

(XI)

【0038】にウルマン反応させて最終的な生成物を得てもよい。本発明においては、前記一般式(I)に示す分子構造により、T_gを100℃以上と高くすることが

でき、この耐熱性の向上により容易には結晶化しない非晶質薄膜を与えることが可能であり、正孔輸送層や電子輸送層等との間における分子の相互拡散を100℃以上の高温下でも十分に抑制することが出来る。

【0039】尚、ビナフチル骨格を有する芳香族ジアミン化合物については、ホール輸送材料として開示されているが(特開平9-255948号公報)、発光機能については一切記載がなく、本発明とは全く異なるものである。前記一般式(I)で表わされるビナフチル骨格を有する芳香族アミン化合物の好ましい具体例を表-1及び表-2に示すが、これらに限定するものではない。表中の置換基で特に記載のないものは水素原子を示す。

【0040】

【表1】

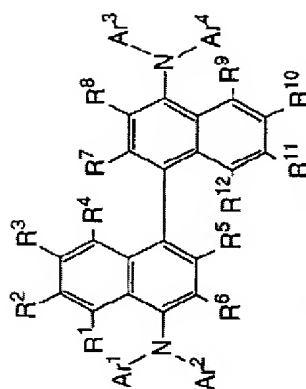
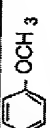
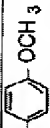
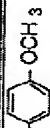
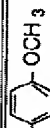
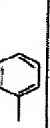
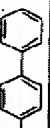



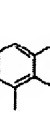
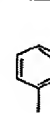
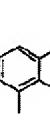



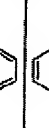

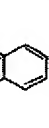
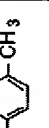
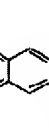

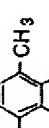
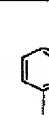
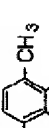




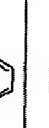
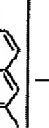
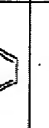
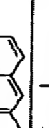





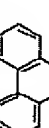
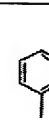


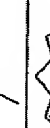




表-1

番号	Ar ¹	Ar ²	Ar ³	Ar ⁴	R ¹ ~R ⁶	R ⁷ ~R ¹²
(1)					—	—
(2)					R ⁹ =CH ₃	R ⁹ =CH ₃
(3)					R ⁹ =CH ₃	R ¹⁰ =CH ₃
(4)					—	—
(5)					R ⁹ =CH ₃	R ⁹ =CH ₃
(6)					—	—
(7)					R ⁹ =CH ₃	R ⁹ =CH ₃
(8)					R ⁹ =CH ₃	R ⁹ =CH ₃

表-2

番号	Ar ¹	Ar ²	Ar ³	Ar ⁴	R ¹ ~R ⁶	R ⁷ ~R ¹²
(9)					R ⁶ =CH ₃	R ⁷ =CH ₃
(10)					R ⁶ =CH ₃	R ⁸ =CH ₃
(11)					R ⁶ =CH ₃	R ⁹ =CH ₃
(12)					R ⁶ =CH ₃	R ¹⁰ =CH ₃
(13)					—	—
(14)					R ⁶ =CH ₃	R ¹¹ =CH ₃
(15)					R ⁶ =CH ₃	R ¹² =CH ₃
(16)					R ⁶ =CH ₃	R ¹³ =CH ₃
(17)					R ⁶ =CH ₃	R ¹⁴ =CH ₃
(18)					R ⁶ =CH ₃	R ¹⁵ =CH ₃
(19)					R ⁶ =CH ₃	R ¹⁶ =CH ₃

【0042】これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じて、各々、混合して用いてもよい。前記一般式(I)から成る発光層5は、正孔輸送層4と同様にして塗布法或いは真空蒸着法により正孔輸送層4上に積層することにより形成される。但し、塗布法の場合には既に薄膜形成されている正孔輸送層を溶解させない溶媒を使用する必要がある。

【0043】発光層5の膜厚は、通常、5~300nm、好ましくは10~100nmである。この様に薄い膜を一様に形成するためには、一般に真空蒸着法がよく用いられる。青色の発光効率を向上させると同時に色純度を改善し、更に素子の駆動寿命を改善するためには、前記発光層材料をホスト材料として、蛍光色素をドーパ

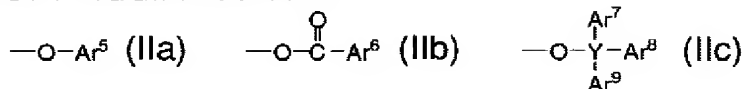
*することは有効な方法である。青色の蛍光を有するドーパ色素として、ペリレン等の縮合多環芳香族環(特開平5-198377号公報)、クマリン誘導体、ナフタル酸イミド誘導体(特開平4-320486号公報)、芳香族アミン誘導体(特開平8-199162号公報)等が挙げられる。これらのドーパ色素が、ホスト材料に含まれる割合は0.1~10重量%の範囲にあることが好ましい。勿論、緑色や赤色蛍光を得るために、緑色蛍光色素や赤色蛍光色素をドーパすることも可能である。真空蒸着法で上記のドーピングを行う方法としては、共蒸着による方法と蒸着源を予め所定の濃度で混合しておく方法がある。

【0044】上記各ドーパントが発光層中にドーパされ

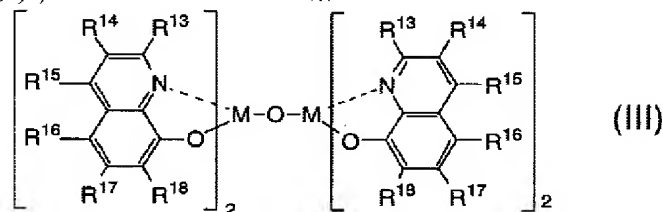
る場合、発光層の膜厚方向において均一にドーピングされるが、膜厚方向において濃度分布があっても差し支えない。例えば、正孔輸送層との界面近傍にのみドーピングしたり、逆に、電子輸送層界面近傍にドーピングしてもよい。発光層5の上には電子輸送層7が設けられる。電子輸送層7は、電界を与えられた電極間において陰極から注入された電子を効率よく発光層5の方向に輸送することができる化合物より形成される。

【0045】電子輸送層7に用いられる電子輸送性化合物としては、陰極8からの電子注入効率が高く、且つ、注入された電子を効率よく輸送することができる化合物であることが必要である。このような条件を満たす材料としては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体等の金属錯体（特開昭59-194393号公報）、10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリンの金属錯体（特開平6-322362号公報）、オキサジアゾール誘導体（特開平2-216791号公報）、ジスチリルビフェニル誘導体（特開平3-231970号公報）、シロール誘導体（特開平9-87616号公報）、3-又は5-ヒドロキシフラボン金属錯体（Appl. Phys. Lett., 71巻, 3338頁, 1997年）、ベンズオキサゾール金属錯体（特開平6-336586号公報）、ベンゾチアゾール金属錯体（特開平9-279134号公報）、トリスベンズイミダゾリルベンゼン（米国特許第5,645,948号明細書）、キノキサリン化合物（特開平6-207169号公報）、フェナントロリン誘導体（特開平5-331459号公報）、2-トープチル-9,10-N,N'-ジシアノアントラキノンジイミン（Phys. Stat. Sol. (a), 142巻, 489頁, 1994年）、n型水素化非晶質炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛等が挙げられる。電子輸送層7の膜厚は、通常、5~200nm、好ましくは10~100nmである。

【0046】有機電界発光素子の発光効率を更に向上さ*



【0050】（式中、YはSi、Ge又はSnのいずれかの原子を示し、Ar⁵ ないしAr⁹は、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わす）

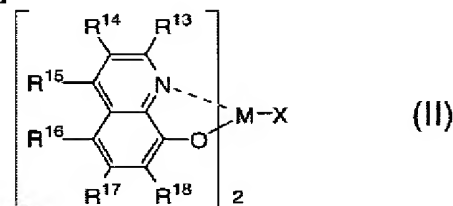


【0052】（式中、R¹³ないしR¹⁸は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アリル基、シアノ基、アミノ基、ア

*せる方法として、発光層5と電子輸送層7の間に正孔阻止層6を積層することは大変効果的である（図2、図3に構造を示す）。正孔阻止層6は、発光層から移動してくる正孔を電子輸送層に注入するのを阻止する役割と、陰極から注入された電子を効率よく発光層5の方向に輸送することができる化合物より形成される。また、発光層5で再結合による生成するエキシトンを発光層内に閉じこめるために、発光層のイオン化ポテンシャルより0.2eV以上大きいイオン化ポテンシャルの値を有する必要がある。正孔阻止層は正孔と電子を発光層内に閉じこめて、発光効率を向上させる機能を有する。このような条件を満たす正孔阻止層材料としては、以下の一般式(II)で表わされる混合配位子錯体、

【0047】

【化17】



【0048】（式中、R¹³ないしR¹⁸は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、アリル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルスルホニル基、α-ハロアルキル基、水酸基、置換基を有していてもよいアミド基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わす。一般式(II)中、MはAl原子又はGa原子を示し、Xは下記一般式(Ia)、(Ib)又は(Ic)のいずれかを表わす）

【0049】

【化18】

*以下の一般式(III)で表わされる二核金属錯体、

【0051】

【化19】

★シル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルスルホニル基、α-ハロアルキル基、水酸基、置換基を有していてもよいアミド基、置換

基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わし、MはA1原子又はGa原子を示す)

以下の構造式(IV)で示される1, 2, 4-トリアゾール環を少なくとも一個有する化合物、

【0053】

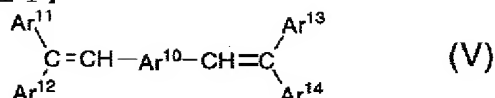
【化20】



【0054】以下の一般式(V)で示されるスチリル化合物が挙げられる。

【0055】

【化21】



【0056】(式中、Ar¹⁰は置換基を有していてもよい二価の芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい二価の芳香族複素環基を表わし、Ar¹¹~Ar¹⁴は、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わす)

【0057】前記一般式(II)で示される混合配位子錯体の具体例として、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(フェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(メタ-クレゾラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラ-クレゾラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(オルト-フェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(メタ-フェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラ-フェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3-ジメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)

(2, 6-ジメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3, 4-ジメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジ-tert-ブチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 6-ジフェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 4, 6-トリフェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 4, 6-トリメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3,

6-トリメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3, 5, 6-テトラメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(1-ナフトラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2-ナフトラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリフェニルシラノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリフェニルゲルマノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリス(4, 4-ビフェニル)シラノラト)アルミニウム、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(オルト-フェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(パラ-フェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(メタ-フェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジ-tert-ブチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラト)(パラ-クレゾラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラト)(パラ-フェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-6-トリフルオロメチル-8-キノリノラト)(2-ナフトラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(フェノラト)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラト)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラ-フェニルフェノラト)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(1-ナフトラト)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2-ナフトラト)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリフェニルシラノラト)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリス(4, 4-ビフェニル)シラノラト)ガリウム等が挙げられる。

【0058】特に好ましくは、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2-ナフトラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリフェニルシラノラト)アルミニウムが挙げられる。前記一般式(III)で表わされる二核金属錯体の具体例として、ビス(2-メチル-8-キノラト)アルミニウム-μ-オキソ-ビス-(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノラト)アルミニウム-μ-オキソ-ビス-(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)アルミニウム、ビス(4-エチル-2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム-μ-オキソ-ビス-(4-エチル-2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-メトキシキノリノ

10

20

30

40

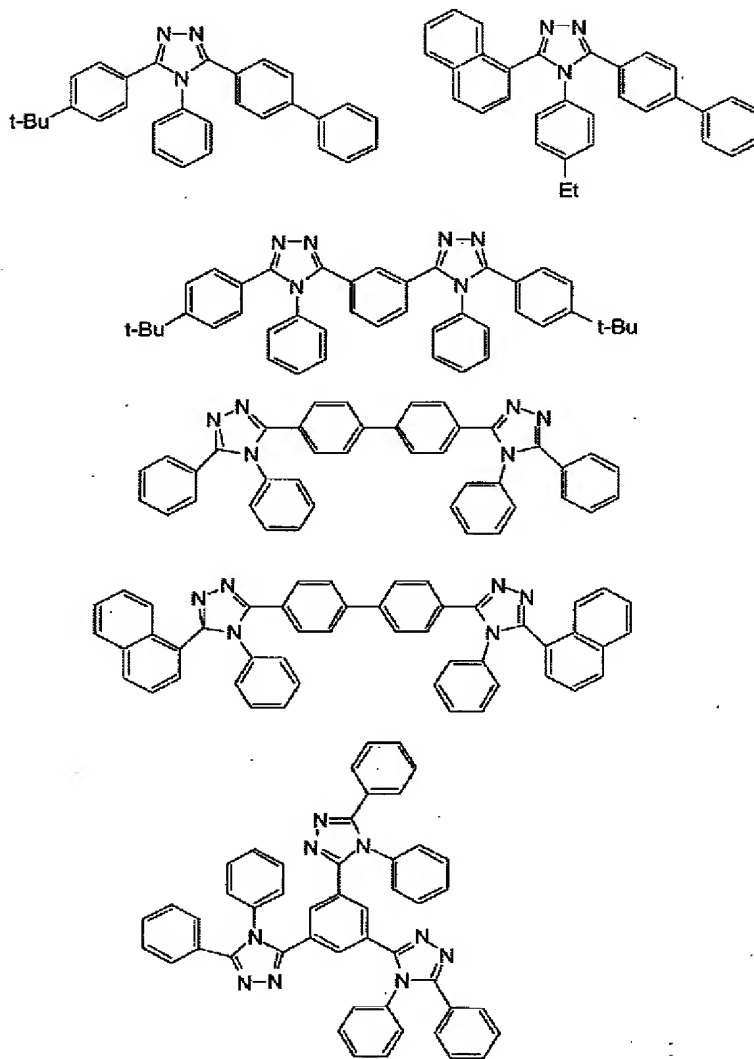
50

ラト) アルミニウム- μ -オキソ-ビス-(2-メチル-4-メトキシキノリノラト) アルミニウム、ビス(5-シアノ-2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム- μ -オキソ-ビス(5-シアノ-2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム、ビス(5-クロロ-2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム- μ -オキソ-ビス(5-クロロ-2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム、ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラト) アルミニウム- μ -オキ*

* ソービス-(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラト) アルミニウム等が挙げられる。特に好ましくは、ビス(2-メチル-8-キノラト) アルミニウム- μ -オキソ-ビス-(2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウムが挙げられる。前記構造式(IV)で表わされる1, 2, 4-トリアゾール環を少なくとも一個有する化合物の具体例を以下に示す。

【0059】

【化22】



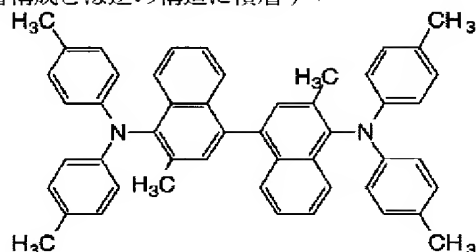
【0060】前記一般式(V)で表わされるスチリル化合物の具体例としては、例えば従来の青色発光材料で例示したジスチリルビフェニル化合物(B-1)が挙げられる。正孔阻止層6の膜厚は、通常、0.3~100nm、好ましくは0.5~10 μ mである。正孔阻止層も正孔輸送層と同様の方法で形成することができるが、通常は真空蒸着法が用いられる。

【0061】陰極8は、電子輸送層7に電子を注入する役割を果たす。陰極8として用いられる材料は、前記陽極2に使用される材料を用いることが可能であるが、効※50

※率よく電子注入を行なうには、仕事関数の低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジウム、カルシウム、アルミニウム、銀等の適当な金属又はそれらの合金が用いられる。具体例としては、マグネシウム-銀合金、マグネシウム-インジウム合金、アルミニウム-リチウム合金等の低仕事関数合金電極が挙げられる。更に、陰極と発光層又は電子輸送層の界面にLiF、Li₂O等のアルカリ金属化合物やアルカリ土類ハロゲン化合物等の極薄膜(0.1~5nm)を挿入することは、素子の効率を向上させる有効な方法である(App1.P

hys. Lett., 70巻, 152頁, 1997年; IEEE Trans. Electron. Devices, 44巻, 1245頁, 1997年; 特願平9-86662号明細書)。陰極8の膜厚は通常、陽極2と同様である。低仕事関数金属から成る陰極を保護する目的で、この上に更に、仕事関数が高く大気に対して安定な金属層を積層することは素子の安定性を増す。この目的のために、アルミニウム、銀、ニッケル、クロム、金、白金等の金属が使われる。

【0062】尚、図1とは逆の構造、即ち、基板上に陰極8、電子輸送層7、発光層5、正孔輸送層4、陽極2の順に積層することも可能であり、既述したように少なくとも一方が透明性の高い二枚の基板の間に本発明の有機電界発光素子を設けることも可能である。同様に、図2及び図3に示した前記各層構成とは逆の構造に積層す*

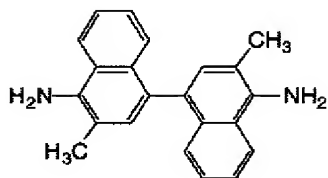


化合物(5)

【0065】下記に示す構造式の3, 3'-ジメチルナフチジン（アルドリッチ社製）1.94g、

【0066】

【化24】



【0067】p-ヨードトルエン6.81g、炭酸カリウム3.73g、ヨウ化銅0.43gを25mlのニトロベンゼンに加え、窒素下、180℃で13時間反応させた。反応終了後、メタノール中に放出し、生じた沈殿物を分別し、水洗後、クロロホルムに溶解させ、シリカゲルによるカラムクロマトグラフィーにより乳白色粉末を得た。この生成物を昇華精製して0.97g回収した。収率は23%であった。融点を測定したところ278℃であった。また、セイコー電子社製DSC-20により示差熱分析測定したところTgは142℃と高い値を示した。この化合物の質量分析を行ったところ分子量が672であり、更にIRスペクトル、NMRスペクトルにより目的化合物であることを確認した。

【0068】〔例示化合物(7)の製造例〕p-ヨードトルエンの代わりにm-ヨードトルエンを用いた他は例示化合物(5)の製造例と同様にして乳白色粉末を得た。この生成物を昇華精製して1.44g回収した。収※50

*ることも可能である。本発明の有機電界発光素子によれば、色純度のよい青色発光が得られ、フルカラー或いはマルチカラーの青色のサブ画素として機能するばかりでなく、蛍光変換色素と組み合わせることによりフルカラー表示素子を作製することも可能である（特開平3-152897号公報）。

【0063】

【実施例】次に、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。

〔例示化合物(5)の製造例〕以下の構造式に示す芳香族アミン（表-1の番号(5)）を合成した。

【0064】

【化23】

※率は23%であった。融点を測定したところ246℃であった。また、セイコー電子社製DSC-20により示差熱分析測定したところTgは120℃と高い値を示した。この化合物の質量分析を行ったところ分子量が672であり、更にIRスペクトル、NMRスペクトルにより目的化合物であることを確認した。

30 【0069】実施例1

ガラス基板をアセトンで超音波洗浄、純水で水洗、イソプロピルアルコールで超音波洗浄、乾燥窒素で乾燥した後、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 2×10^{-6} Torr (約 2.7×10^{-4} Pa) 以下になるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。上記装置内に配置されたセラミック坩堝に入れた化合物(5)を、坩堝の周囲のタングステンヒーターで加熱して蒸着を行った。この時の坩堝の温度は、270～310℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は 4×10^{-6} Torr (約 5.3×10^{-4} Pa) で、蒸着速度0.5nm/秒で膜厚88nmの薄膜を得た。この薄膜試料のイオン化ポテンシャルを理研計器(株)製の紫外線電子分析装置(AC-1)を用いて測定したところ、5.09eVと低い値を示した。また、この薄膜試料を大気中室温で二年間保存しても、膜の形状は均一なままで安定で、結晶化は見られなかった。

【0070】実施例2

実施例1と同様にして化合物(7)の薄膜を形成した。この時の坩堝の温度は、260～280℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は 5×10^{-6} Torr (約6.7

$\times 10^{-4}$ Pa) で、蒸着速度 $0.3 \sim 0.5$ nm/秒で膜厚 81 nm の薄膜を得た。この薄膜試料のイオン化ポテンシャルは、 5.05 eV と低い値を示した。また、この薄膜試料を大気中で二年間保存しても、膜の形状は均一なままで安定で、結晶化は見られなかった。

【0071】比較例1

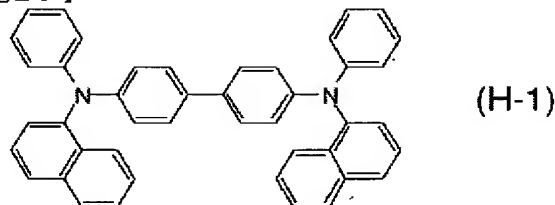
蒸着原料として芳香族ジアミン (B-3) を用いた他は実施例1と同様にしてガラス基板上に薄膜を形成した。この薄膜試料は大気中三日保存後に結晶化が起きて、均一な薄膜形状は失われた。

【0072】実施例3

図2に示す構造を有する有機電界発光素子を以下の方法で作製した。ガラス基板上にインジウム・スズ酸化物 (ITO) 透明導電膜を 120 nm 堆積したもの (ジオマテック社製; 電子ビーム成膜品; シート抵抗 15Ω) を通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いて 2 mm 幅のストライプにパターンニングして陽極を形成した。パターン形成した ITO 基板を、アセトンによる超音波洗浄、純水による水洗、イソプロピルアルコールによる超音波洗浄の順で洗浄後、窒素ブローで乾燥させ、最後に紫外線オゾン洗浄を行って、真空蒸着装置内に設置した。上記装置の粗排気を油回転ポンプにより行った後、装置内の真空度が 2×10^{-6} Torr (約 2.7×10^{-4} Pa) 以下になるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。上記装置内に配置されたセラミック坩堝に入れた。下記に示す4,4'-ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニル (H-1) を実施例

【0073】

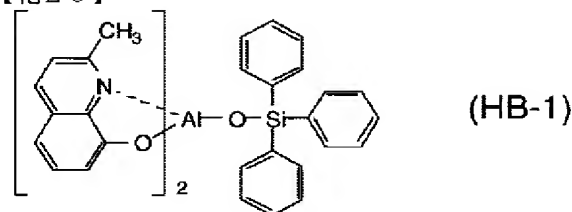
【化25】



【0074】1と同様にして蒸着を行った。この時の坩堝の温度は $220 \sim 250^\circ\text{C}$ で制御した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-6} Torr (約 1.3×10^{-4} Pa)、蒸着速度 0.4 nm/秒で膜厚 60 nm の正孔輸送層4を得た。この正孔輸送材料のイオン化ポテンシャルは 5.25 eV であった。続いて、発光層5の材料として表-1の化合物(5)を実施例1と同様にして蒸着を行った。蒸着時の真空度は 7×10^{-7} Torr (約 9.3×10^{-5} Pa)、蒸着速度 0.4 nm/秒で膜厚 30 nm の発光層5を正孔輸送層4の上に積層した。次に、発光層5の上に、正孔阻止層6として以下の構造式に示す、ビス(2-メチルー8-キノリノラト) (トリフェニルシラノラト) アルミニウム (HB-

【0075】

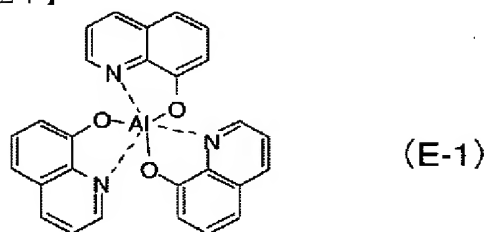
【化26】



【0076】1) を蒸着した。この時の (HB-1) の坩堝の温度は、 $180 \sim 190^\circ\text{C}$ の範囲で制御した。蒸着時の真空度 8×10^{-6} Torr (約 1.1×10^{-4} Pa)、蒸着速度を 0.3 nm/秒で、膜厚 20 nm の正孔阻止層6を得た。この化合物のイオン化ポテンシャルは 5.51 eV であった。有機層の最後として、以下の構造式に示すアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体、 $\text{Al}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3$ (E-1)、を用いて電子輸送層7を形成した。

【0077】

【化27】



【0078】この時の坩堝温度は $310 \sim 325^\circ\text{C}$ の範囲で制御し、蒸着時の真空度は 6.6×10^{-7} Torr (約 8.8×10^{-5} Pa)、蒸着速度は 0.3 nm/秒で、膜厚 25 nm の電子輸送層7を得た。この電子輸送層に用いた錯体のイオン化ポテンシャルは 5.41 eV であった。尚、上記の正孔輸送層4から電子輸送層7までを真空蒸着する時の基板温度は室温に保持した。

【0079】ここで、電子輸送層7までの蒸着を行った素子を一度前記真空蒸着装置内より大気中に取り出して、陰極蒸着用のマスクとして 2 mm 幅のストライプ状シャドーマスクを、陽極2の ITO ストライプとは直交するように素子に密着させて、別の真空蒸着装置内に設置して有機層と同様にして装置内の真空度が 2×10^{-6} Torr (約 2.7×10^{-4} Pa) 以下になるまで排気した。陰極8として、先ず、フッ化マグネシウム (MgF_2) をモリブデンボートを用いて、蒸着速度 0.05 nm/秒、真空度 3.4×10^{-6} Torr (約 4.5×10^{-4} Pa) で、 0.5 nm の膜厚で電子輸送層7の上に成膜した。次に、アルミニウムを同様にモリブデンボートにより加熱して、蒸着速度 $0.4 \sim 0.6$ nm/秒、真空度 1×10^{-5} Torr (約 1.3×10^{-3} Pa) で膜厚 40 nm のアルミニウム層を形成した。更に、その上に、陰極の導電性を高めるために銅を、同様にモリブデンボートにより加熱して、蒸着速度 0.5 nm/秒、真空度 6×10^{-6} Torr (約 8×10^{-4} Pa)

a)で膜厚40nmの銅層を形成して陰極8を完成させた。以上の三層型陰極8の蒸着時の基板温度は室温に保持した。

【0080】以上の様にして、2mm×2mmのサイズの発光面積部分を有する有機電界発光素子が得られた。この素子の発光特性を表-3に示す。表-3において、発光輝度は250mA/cm²の電流密度での値、発光*

*効率は100cd/m²での値、輝度/電流は輝度-電流密度特性の傾きを、電圧は100cd/m²での値を各々示す。ELスペクトルのピーク極大波長とCIE色度座標値をあわせて示す。発光色は緑がかった青色であった。

【0081】

【表3】

表-3

	発光輝度 [cd/m ²] @250mA/cm ²	発光効率 [lm/W] @100cd/m ²	輝度/電流 [cd/A]	電圧 [V] @100cd/m ²	発光極大波長 [nm]	CIE色度座標	
						x	y
実施例3	6890	1.69	4.3	8	483	0.202	0.301
実施例4	6610	1.03	2.9	9	483	0.207	0.309
実施例5	5330	0.92	3.2	11	449	0.169	0.195
比較例2	8570	1.80	3.4	6	530	0.329	0.556
比較例4	1690	0.25	0.7	10	506	0.258	0.355
比較例5	1660	0.28	0.7	9	474	0.187	0.262

【0082】実施例4

発光層として化合物(7)を用いた他は実施例3と同様に素子を作製した。発光特性を表-3に示す。発光色は緑がかった青色であった。

実施例5

発光層中に1.2重量%の濃度で膜厚方向で均一にペリレンを二元蒸着法でドーピングした他は実施例3と同様に素子を作製した。この素子の発光特性を表-3に示す。ペリレンのドーピングにより、色度座標は完全に青色領域に入った。

【0083】比較例2

正孔阻止層を設けず、電子輸送層の膜厚を45nmとした他は実施例3と同様に素子を作製した。この素子の発光特性を表-3に示す。青色発光は得られず、電子輸送層として用いたアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体からの緑色発光が観測された。

【0084】比較例3

正孔輸送層を設けず、発光層の膜厚を60nmとした他は実施例4と同様に素子を作製した。この素子の発光輝度は20cd/m²と非常に低かった。

比較例4

発光層として45nmの膜厚の前記化合物(B-2)を用い、電子輸送層として30nmの(E-1)を用いた他は実施例3と同様に素子を作製した。この素子の発光特性を表-3に示す。輝度、発光効率共に低く、発光色も青みがかった緑色であった。

※【0085】比較例5

発光層中に1.0重量%の濃度で膜厚方向で均一にペリレンを二元蒸着法でドーピングした他は比較例2と同様に素子を作製した。この素子の発光特性を表-3に示す。ペリレンのドーピングにより青色発光にはなったものの、輝度、発光効率は改善されなかった。

【0086】

【発明の効果】本発明の有機電界発光素子によれば、特定の芳香族アミンを含有する発光層を有するために、色純度の良好な青色発光が達成でき、また安定性の向上した素子を得ることができる。従って、本発明による有機電界発光素子はフラットパネル・ディスプレイ(例えばOAコンピュータ用や壁掛けテレビ)やマルチカラー表示素子、或いは面発光体としての特徴を生かした光源(例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイや計器類のバックライト光源)、表示板、標識灯への応用が考えられ、特に、高耐熱性が要求される車載用、屋外用表示素子としては、その技術的価値は大きいものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例を示した模式断面図。

【図2】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面図。

【図3】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面図。

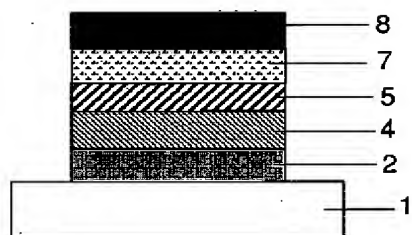
【符号の説明】

※50 1 基板

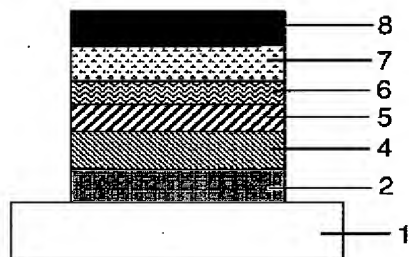
- 2 陽極
- 3 陽極バッファ層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層

- 6 正孔阻止層
- 7 電子輸送層
- 8 陰極

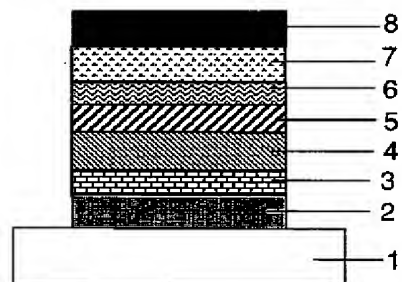
【図1】



【図2】



【図3】



PAT-NO: JP411302639A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11302639 A
TITLE: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT
ELEMENT
PUBN-DATE: November 2, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
SATO, YOSHIHARU	N/A
ICHINOSAWA, AKIKO	N/A
OGATA, TOMOYUKI	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
MITSUBISHI CHEMICAL CORP	N/A

APPL-NO: JP10118249

APPL-DATE: April 28, 1998

PRIORITY-DATA: 10034529 (February 17, 1998)

INT-CL (IPC): C09K011/06 , H05B033/14

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element which can accomplish a blue emission of a good color purity and has

improved stability.

SOLUTION: There is provided an organic electroluminescent element essentially consisting of a substrate and a hole transport layer sandwiched between an anode and a cathode, a luminescent layer, and an electron transport layer which are formed on the substrate, wherein the luminescent layer contains a binaphthyl-skeleton-containing aromatic amine represented by the formula (wherein Ar1 and Ar4 are each independently an aromatic hydrocarbon group which may be substituted or an aromatic heterocyclic group which may be substituted; R1 to R12 are each independently hydrogen, cyano, carboxy, hydroxy, or an alkyl, aralkyl, alkenyl, amino, amido, alkoxycarbonyl, alokoxy, aryloxy, aromatic hydrocarbon, or aromatic heterocyclic group each of which may be substituted).

COPYRIGHT: (C)1999,JPO